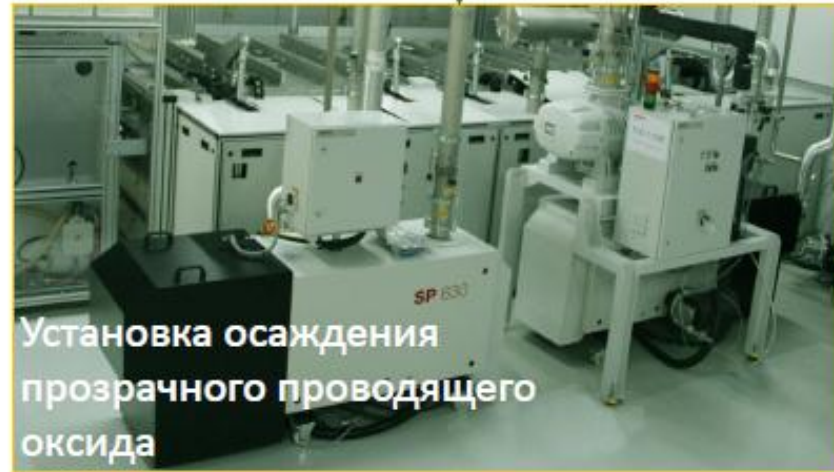
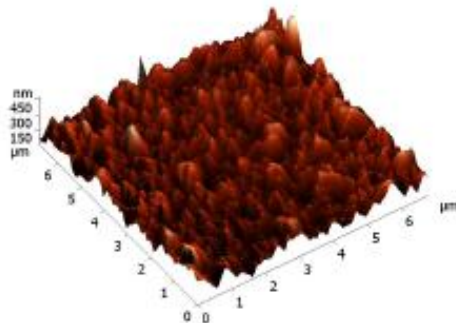




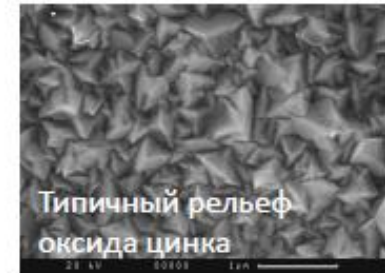
Установка осаждения оксида цинка TCO 1-1200



Назначение:



Осаждение лицевого и тыльного контактов солнечного модуля.





Установка осаждения оксида цинка TCO 1-1200

Параметры осаждения:

Метод - химическое осаждение металлоорганических прекурсоров при пониженном давлении

Прекурсоры – диэтил цинка и вода (пары)

Легирующий газ – диборан

Возможно варьирование потоков газов

Рабочая температура – от 150 до 200 °С

Рабочее давление – от 0,3 до 1,5 мбар

Скорость осаждения – до 3,5 нм/с

Максимальная площадь осаждения - 1,1x1,3 м²

Неравномерность по толщине на площади 1,4 м² - менее 15%